ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՄՊԵՔՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Pulsed Laser Deposition system with laser system	Pulsed Laser Deposition system with laser system-	Pulsed Laser Deposition system with laser system	ZHENGZHOU CY SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD	Հիմնական վակուումային համակարգ՝ չափս՝ Ø 300-450 մմ Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Ուղղահայաց գլանաձև կառուցվածք, չափս՝ Ø 120×120-160×160 մմ Վակուումային համակարգի կոնֆիգուրացիա Հիմնական վակուումային խցիկ՝ Մեխանիկական պոմպ, մոլեկուլային պոմպ, փական Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Մեխանիկական պոմպ և մոլեկուլային պոմպ (առաջնային խցիկի հետ համատեղ), փական Առավելագույն ճնշում Հիմնական վակուումային համակարգ՝

						≤1*10^-6Պա (նախապատրաստումից և գազազերծումից հետո) Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ ≤1*10^-3 Պա (նախապատրաստումից և գազազերծումից հետ ո) Վակուումի վերականգնման համակարգ Հիմնական վակուումային համակարգ՝ Այն կարող է հասնել (5-1)x10^-3 Պա-ի 10-20 րոպեում (համակարգը կարճ ժամանակով ենթարկվում է մթնոլորտի ազդեցությանը և լցվում է չոր ազոտով, որպեսզի սկսվի վակուումի վերականգնումը) Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Այն կարող է հասնել 5x10^-3 Պա-ի 20 րոպեում (համակարգը կարճ ժամանակով ենթարկվում է մթնոլորտի ազդեցությանը և լցվում է չոր ազոտով, որպեսզի սկսվի վակուումի վերականգնումը) Թիրախի պտտվող հարթակ՝ Թիրախի առավելագույն չափը մոտ 60 մմ է: Կարելի է միաժամանակ տեղադրվել չորս թիրախային նյութեր, թիրախը կարելի է փոփոխել պտույտի միջոցով, յուրաքանչյուր թիրախ կարող է ինքնուրույն պտտվել,

						պտտման արագությունը՝ 5-60 պտ/րոպ. Ենթաշերտի տաքացում Նմուշի չափը՝ Ø40-60 Շարժման ռեժիմ՝ Ենթաշերտը անընդհատ պտտվում է, պտտման արագությունը՝ 5-70 պտ/րոպ. Ջեռուցման ջերմաստիճանը՝ Ենթաշերտի տաքացման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 900℃±1℃ (վերահսկվող և կարգավորելի) Գազի շրջապտույտի համակարգ՝ 1-ցիկլի գազի հոսքի կարգավորիչ, 1- ցիկլի փչող փական Լրացուցիչ պարագաներ Լազերային սարք՝ Համատեղելի է կոհերենտ լազերների հետ Լազերային ճառագայթների սկանավորման սարք՝ 2D սկանավորման մեխանիկական հարթակ, կատրում է ազատության երկու աստիճանի սկանավորում: Համակարգչային կառավարման համակարգ՝ Վերահսկողությունը իր մեջ ներառում է թիրախի ընդհանուր փոփոխություն, թիրախի ռոտացիա, նմուշի ռոտացիա, նմուշի ջերմաստիճանի կառավարում, լազերային ճառագայթով սկանավորում և այլն: Ձբաղեցրած

						տարածք Հիմնական միավոր՝ 1600 * 1600-1900 * 1900 մմ^2 Էլեկտրական խցիկ՝600 *600-800 *800 մմ2 (մեկ) Հիմնական լազերային համակարգ՝ AO-S-1064-532 Լազեր Ալիքային ազդանշանի ալիքի երկարություն (նմ)՝ 532-1064 ± 1 Աշխատանքային ռեժիմ՝ Acousto-optics Q - անջատելի Մեկ իմպուլսի էներգիա (մJ)՝ 1-350 (350 մՋ 1 կՀց-ում; 180 մՋ 10 կՀց-ում) Կրկնման տեմպի հաճախություն (ՄՀց)՝ 0,1-100 Իմպուլսի տևողություն՝ Սովորաբար 7-11 նվրկ <10կՀց հաճախությունների դեպքում, կախված է հզորությունից և կրկնելիությունից Միջին հզորություն (մՎտ)՝ Միջին հզորությունը (մՎտ) = մեկ իմպուլսի էներգիա (մJ)* կրկնելիության հաճախություն (ՄՀց) Էլեկտրաէներգիայի կայունություն (4 ժամ RMS)՝ < 3 %, < 5 %, < 10 %, Լայնակի ռեժիմ՝ TEMoo M2 գործակից՝ < 1,5 Ճառագայթի տրամագիծը բացվածքում (1/e2, մմ)՝ -1,3 (ընտրովի); -0,4 Ճառագայթների շեղում, ամբողջ անկյուն (mrad)՝ < 1,5 (ընտրովի); < 5,0 Բևեռացման

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИМПЕКС ГРУПП СПБ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БКЧЧ-ЕИДЦПЭЕ-24/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
1	Pulsed Laser Deposition system with laser system	Pulsed Laser Deposition system with laser system	Pulsed Laser Deposition system with laser system	ZHENGZHOU CY SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD	Հիմնական վակուումային համակարգ՝ չափս՝ Ø 300-450 մմ Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Ուղղահայաց գլանաձև կառուցվածք, չափս՝ Ø 120×120-160×160 մմ Վակուումային համակարգի կոնֆիգուրացիա Հիմնական վակուումային խցիկ՝ Մեխանիկական պոմպ, մոլեկուլային պոմպ, փական Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Մեխանիկական պոմպ և մոլեկուլային պոմպ (առաջնային խցիկի հետ համատեղ), փական Առավելագույն ճնշում Հիմնական վակուումային համակարգ՝ գործակից՝ >100 : 1 Հորիզոնական ± 5 աստիճան Տաքացման ժամանակ (րոպե)՝ < 10 Ճառագայթի բարձրությունը տակդիրից (մմ)՝ 15-20 Աշխատանքային ջերմաստիճան (oC)՝ 10-35 Սնման աղբյուր (90-264 Վտ փոփոխական հոսանք)՝ PSU – AOM - DL Ակնկալվող աշխատանքային ժամանակահատված (ժամ)՝ 1 0000-50000 Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի * «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն հիմնական գնանշված հոմսկ ցեսքրսմ կիրառելի են «կամ համարժեք», բառերը:

						≤1*10^-6Պա (նախապատրաստումից և գազազերծումից հետո) Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ ≤1*10^-3 Պա (նախապատրաստումից և գազազերծումից հետ ո) Վակուումի վերականգնման համակարգ Հիմնական վակուումային համակարգ՝ Այն կարող է հասնել (5-1)x10^-3 Պա-ի 10-20 րոպեում (համակարգը կարճ ժամանակով ենթարկվում է մթնոլորտի ազդեցությանը և լցվում է չոր ազոտով, որպեսզի սկսվի վակուումի վերականգնումը) Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Այն կարող է հասնել 5x10^-3 Պա-ի 20 րոպեում (համակարգը կարճ ժամանակով ենթարկվում է մթնոլորտի ազդեցությանը և լցվում է չոր ազոտով, որպեսզի սկսվի վակուումի վերականգնումը) Թիրախի պտտվող հարթակ՝ Թիրախի առավելագույն չափը մոտ 60 մմ է: Կարելի է միաժամանակ տեղադրվել չորս թիրախային նյութեր, թիրախը կարելի է փոփոխել պտույտի միջոցով, յուրաքանչյուր թիրախ կարող է ինքնուրույն պտտվել,

						պտտման արագությունը՝ 5-60 պտ/րոպ. Ենթաշերտի տաքացում Նմուշի չափը՝ Ø40-60 Շարժման ռեժիմ՝ Ենթաշերտը անընդհատ պտտվում է, պտտման արագությունը՝ 5-70 պտ/րոպ. Ջեռուցման ջերմաստիճանը՝ Ենթաշերտի տաքացման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 900℃±1℃ (վերահսկվող և կարգավորելի) Գազի շրջապտույտի համակարգ՝ 1-ցիկլի գազի հոսքի կարգավորիչ, 1- ցիկլի փչող փական Լրացուցիչ պարագաներ Լազերային սարք՝ Համատեղելի է կոհերենտ լազերների հետ Լազերային ճառագայթների սկանավորման սարք՝ 2D սկանավորման մեխանիկական հարթակ, կատրում է ազատության երկու աստիճանի սկանավորում: Համակարգչային կառավարման համակարգ՝ Վերահսկողությունը իր մեջ ներառում է թիրախի ընդհանուր փոփոխություն, թիրախի ռոտացիա, նմուշի ռոտացիա, նմուշի ջերմաստիճանի կառավարում, լազերային ճառագայթով սկանավորում և այլն: Ձբաղեցրած

						տարածք Հիմնական միավոր՝ 1600 * 1600-1900 * 1900 մմ^2 Էլեկտրական խցիկ՝600 *600-800 *800 մմ2 (մեկ) Հիմնական լազերային համակարգ՝ AO-S-1064-532 Լազեր Ալիքային ազդանշանի ալիքի երկարություն (նմ)՝ 532-1064 ± 1 Աշխատանքային ռեժիմ՝ Acousto-optics Q - անջատելի Մեկ իմպուլսի էներգիա (մJ)՝ 1-350 (350 մՋ 1 կՀց-ում; 180 մՋ 10 կՀց-ում) Կրկնման տեմպի հաճախություն (ՄՀց)՝ 0,1-100 Իմպուլսի տևողություն՝ Սովորաբար 7-11 նվրկ <10կՀց հաճախությունների դեպքում, կախված է հզորությունից և կրկնելիությունից Միջին հզորություն (մՎտ)՝ Միջին հզորությունը (մՎտ) = մեկ իմպուլսի էներգիա (մJ)* կրկնելիության հաճախություն (ՄՀց) Էլեկտրաէներգիայի կայունություն (4 ժամ RMS)՝ < 3 %, < 5 %, < 10 %, Լայնակի ռեժիմ՝ TEMoo M2 գործակից՝ < 1,5 Ճառագայթի տրամագիծը բացվածքում (1/e2, մմ)՝ -1,3 (ընտրովի); -0,4 Ճառագայթների շեղում, ամբողջ անկյուն (mrad)՝ < 1,5 (ընտրովի); < 5,0 Բևեռացման

					գործակից՝ >100 : 1 Հորիզոնական ± 5 աստիճան Տաքացման ժամանակ (րոպե)՝ < 10 Ճառագայթի բարձրությունը տակդիրից (մմ)՝ 15-20 Աշխատանքային ջերմաստիճան (oC)՝ 10-35 Սնման աղբյուր (90-264 Վտ փոփոխական հոսանք)՝ PSU – AOM - DL Ակնկալվող աշխատանքային ժամանակահատված (ժամ)՝ 1 0000-50000 Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի * «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը: